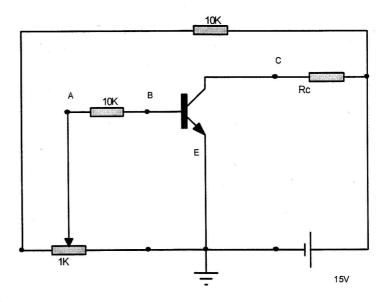
4.2 Teorik

1. Aşağıda verilen devrede hfe= 260, V_{BE} =0,6V, R_{C} = 2X.Y $k\Omega$ olduğuna göre;

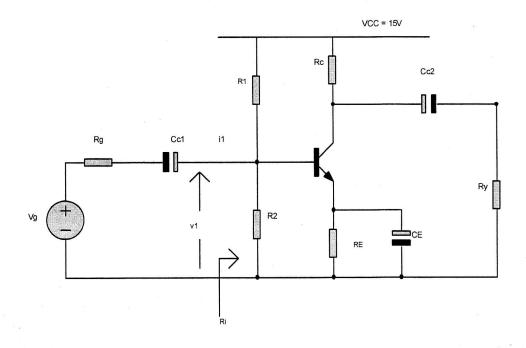


a) V_{AE} = 0 iken V_{CE} ve I_{C} değerlerini hesaplayınız.

b) Yukarıdaki devrede P potansiyometresini kullanarak Ic akımını 1 mA'den başlayarak 1mA aralıklarla arttırarak bu değerlere karşı düşen V_{CE} , V_{AE} ve V_{BE} değerlerini hesaplayınız.

Ic	V_{CE}	V_{AE}	$ m V_{BE}$
(mA)	V _{CE} (V)	V _{AE} (V)	V _{BE} (V)
		7) AS 31 88	
		2	
2			
- No 1 , x xxx 1			
	ii.		
	-	1 17 July 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Aşağıdaki devrede $R_E=1X.Y~k\Omega,~Rc=2X.Y~k\Omega,~C_E=220~\mu F,~Ry=12~k\Omega,~Rg=10~k\Omega,~Cc1=5\mu F,~R1=220k,~R2=33K~olarak~verilmiştir.$



a) BC238 silisyum tranzistoru için hfe=260, V_{BE}=0,6 V olduğuna göre; bu devrenin doğru akım ve gerilimleri ile S ısıl kararlılık katsayısını hesaplayınız. (Hesabı klaylaştırmak için I_B akımı R1 ve R2 dirençleri üzerinden akan akım yanında ihmal edilebilir.)

b) hie=8 k Ω , hfe=320, hre= 4.10⁻⁴, hoe = 20 μ A/V verilmiştir. Bu değerlerden yararlanarak Kv= V2/V1 değerini hesaplayınız.

c) Ry= 12 k Ω luk direnç yerine Ry= 4X.Y k Ω luk direnç bağlanırsa yeni elde edilen devrenin kazancı ne olur?

d) Ry= 12 k Ω ve C_E kondansatörü açık devre edilirse, devrenin kazancını eşdeğer devre yardımı ile hesaplayınız.